



中国科学院科学出版基金资助出版

半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 20 卷 第 7 期 1999 年 7 月

目 次

研究论文

- 氮化镓缓冲层生长过程分析..... 刘祥林 汪连山 陆大成 王晓晖 汪 度 林兰英 (529)
- 掺硅氮化镓材料的 MOVPE 生长及其性质研究 刘祥林 汪连山 陆大成 汪 度 王晓晖 林兰英 (534)
- AlN/GaAs 界面的 AES 和 XPS 研究 曹 昕 罗晋生 陈堂胜 陈克金 (539)
- 同步辐射光电子能谱对 ITO 表面的研究 来 冰 丁训民
袁泽亮 周 翔 廖良生 张胜坤 袁 帅 侯晓远 陆尔东 徐彭寿 张新夷 (543)
- CdTe 单晶中主要中性受主束缚激子起因的研究 杨柏梁 石川幸雄 一色 实 (548)
- Si(100)衬底上部分弛豫外延薄层 Ge 膜的应变研究 裴成文 秦 捷 刘晓晗
胡冬枝 张翔九 黄大鸣 蒋最敏 贾全杰 郑文莉 王洲光 王 俊 姜晓明 (554)
- 低温 Si-GSMBE 中 Si₂H₆ 的热裂解及对 Si 生长的影响 李建平 黄大定 刘金平 刘学锋 李灵宵 朱世荣 孙殿照 孔梅影 (559)
- 高温退火时化学计量比偏离对 GaAs 晶体气固相平衡的影响 赵福川 夏冠群 杜立新 谈惠祖 莫培根 (562)
- 离子注入对分子束外延 Hg_{0.68}Cd_{0.32}Te 远红外振动模的影响 姬荣斌 李 标 方维政 王善力 杨建荣 何 力 (569)
- Si δ-掺杂 In_{0.2}Ga_{0.8}As/GaAs 应变单量子阱光致发光研究 窦红飞 陈效双 陆 卫 李志锋 沈学础 G. Li C. Jagadish (573)
- 1.3 μm 混合应变量子阱激光器偏振特性分析 张哲民 金锦炎 黄格凡 黄德修 李同宁 (578)
- 基于快速热退火量子阱无序技术的新型半导体激光器 姜艾庆 郝智彪 孙长征 罗 毅 王健华 (584)
- ECR Plasma CVD 法淀积 808nm 大功率半导体激光器光学膜工艺研究 谭满清 茅冬生 (589)
- PINIP 结构 a-Si:H 多色光电探测器电路模型研究 陈维友 刘式墉 (593)
- 新型隐埋 Si/SiO₂ 做底镜的共振腔型探测器的理论分析 李 成 杨沁清 王启明 (601)
- 半导体制冷器“无限级联”温差电对工作参数的理论分析 宣向春 王维扬 (606)

研究快报

- Analytical Calculation of Avalanche Breakdown Voltage of the Single-Diffused Junction Based on Double-sided Asymmetric Linearly Graded Approximation He Jin(何进) Wang Xin(王新) Chen Xingbi(陈星弼) (612)

研究简报

- 一种改进的电流型排序电路 林 谷 石秉学 (619)
- 切割曝光技术及其在器件研究上的应用 海潮和 陈焕章 周小茵 陈宝钦 刘改芬 (624)
- Si(100)面上 3C-SiC 的生长 王引书 李晋闽 张方方 林兰英 (630)